

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

**№ 110472**

**ТЕНЗОРЕЗИСТОР (ВАРИАНТЫ)**

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной  
ответственностью "Эс эм Эс - Тензо" (RU)*

Автор(ы): *Каминский Владимир Васильевич (RU), Соловьёв  
Сергей Михайлович (RU), Голубков Александр Васильевич  
(RU), Володин Николай Михайлович (RU)*

Заявка № 2011118769

Приоритет полезной модели **10 мая 2011 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных  
моделей Российской Федерации **20 ноября 2011 г.**

Срок действия патента истекает **10 мая 2021 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности, патентам и товарным знакам

Б.П. Симонов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

**(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ**

(21)(22) Заявка: 2011118769/28, 10.05.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
10.05.2011

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 10.05.2011

(45) Опубликовано: 20.11.2011 Бюл. № 32

Адрес для переписки:

194021, Санкт-Петербург, ул.  
Политехническая, 26, Патентно-  
лицензионная служба ФТИ им. А.Ф. Иоффе  
РАН

(72) Автор(ы):

Каминский Владимир Васильевич (RU),  
Соловьёв Сергей Михайлович (RU),  
Голубков Александр Васильевич (RU),  
Володин Николай Михайлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной  
ответственностью "Эс эм Эс - Тензо" (RU)

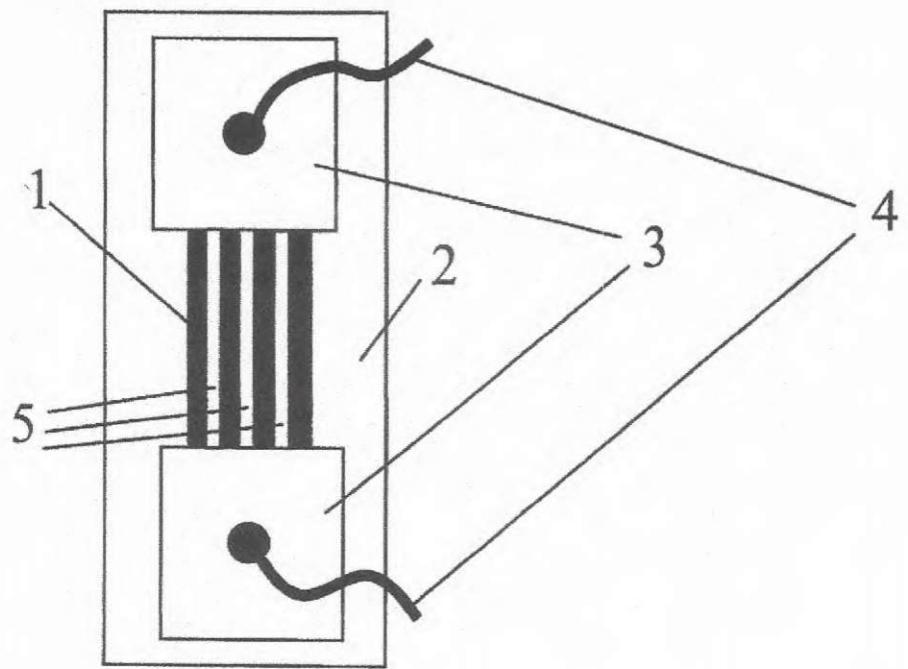
**(54) ТЕНЗОРЕЗИСТОР (ВАРИАНТЫ)**

**(57) Формула полезной модели**

1. Тензорезистор для измерения деформаций и давления, включающий диэлектрическую подложку с нанесенным тензочувствительным слоем в виде поликристаллической пленки, содержащей сульфид самария, и металлическими контактными площадками, расположенными на одной поверхности пленки, с припаянными к ним токовыводами, отличающийся тем, что тензочувствительный слой выполнен с отверстиями, соединяющими контактные площадки, и имеет состав  $\text{Sm}_{1-x}\text{Ln}_x\text{S}$ , где  $\text{Ln}$  - один из элементов: La, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Y, при  $0 < x < 0,3$ .

2. Тензорезистор для измерения деформаций и давления, включающий диэлектрическую подложку с нанесенным тензочувствительным слоем в виде поликристаллической пленки, содержащей сульфид самария, и металлическими контактными площадками, расположенными на одной поверхности пленки, с припаянными к ним токовыводами, отличающийся тем, что тензочувствительный слой выполнен с отверстиями, соединяющими контактные площадки, и имеет состав  $\text{Sm}_{1+z}\text{S}$ , где  $0 < z \leq 0,17$ .

RU 110472 U1



R U 1 1 0 4 7 2 U 1

